

# 2SC4288A

シリコンNPN三重拡散メサ形

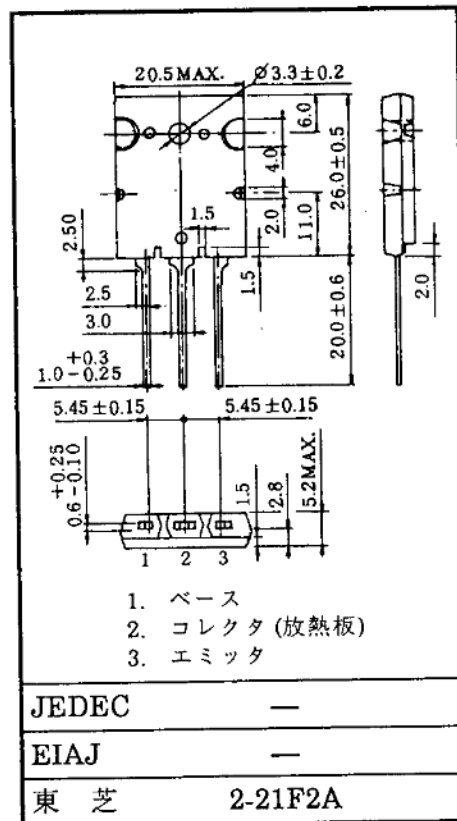
- 高精細度ディスプレイ水平出力用
- カラーテレビ水平出力用
- カラーテレビスイッチング電源出力用

- ・ 高耐圧です。 :  $V_{CBO} \geq 1500V$
- ・ 飽和電圧が低い。 :  $V_{CE(sat)} \leq 5V$  ( $I_C=10A$ ,  $I_B=2.5A$ )
- ・ スイッチング時間が速い。  
:  $t_f=0.1\mu s$  (標準) ( $I_{CP}=10A$ ,  $I_{B1(end)}=2A$ )

最大定格 ( $T_c=25^\circ C$ )

| 項 目          | 記 号       | 定 格      | 単位         |
|--------------|-----------|----------|------------|
| コレクタ・ベース間電圧  | $V_{CBO}$ | 1500     | V          |
| コレクタ・エミッタ間電圧 | $V_{CEO}$ | 600      | V          |
| エミッタ・ベース間電圧  | $V_{EBO}$ | 5        | V          |
| コレクタ電流       | 直 流       | $I_C$    | A          |
|              | パルス       | $I_{CP}$ |            |
| ベ ー ス 電 流    | $I_B$     | 6        | A          |
| コ レ ク タ 損 失  | $P_C$     | 200      | W          |
| 接 合 温 度      | $T_j$     | 150      | $^\circ C$ |
| 保 存 温 度      | $T_{stg}$ | -55~150  | $^\circ C$ |

単位 : mm



電気的特性 ( $T_c=25^\circ C$ )

| 項 目            |                   |      | 記 号       | 測 定 条 件                                         | 最小 | 標準  | 最大  | 単位  |
|----------------|-------------------|------|-----------|-------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| コレクタシャ断電流      |                   |      | ICBO      | VCB=1500V, IE=0                                 | —  | —   | 1   | mA  |
| エミッタシャ断電流      |                   |      | IEBO      | VEB=5V, IC=0                                    | —  | —   | 100 | μA  |
| 直 流 電 流 増 幅 率  |                   |      | hFE       | VCE=5V, IC=3A                                   | 8  | —   | —   |     |
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧 |                   |      | VCE (sat) | IC=10A, IB=2.5A                                 | —  | —   | 5.0 | V   |
| ベース・エミッタ間飽和電圧  |                   |      | VBE (sat) | IC=10A, IB=2.5A                                 | —  | —   | 2.0 | V   |
| トランジション周波数     |                   |      | fT        | VCE=10V, IC=0.1A                                | 1  | 3   | —   | MHz |
| コレクタ出力容量       |                   |      | Cob       | VCB=10V, IE=0, f=1MHz                           | —  | 400 | —   | pF  |
| スイッチング時間       | インダクタンス負荷<br>(図1) | 蓄積時間 | tstg      | ICP=10A, IB1(end)=1.8A,<br>LY=130μH, CY=23000pF | —  | 4.0 | 6.0 | μs  |
|                |                   | 下降時間 | tf        |                                                 | —  | 0.1 | 0.3 |     |
|                | 抵抗負荷<br>(図2)      | 蓄積時間 | tstg      | IC=10A, IB1=1.8A,<br>IB2=−3.6A, RL=20Ω          | —  | 2.0 | 3.0 |     |
|                |                   | 下降時間 | tf        |                                                 | —  | 0.1 | 0.2 |     |